

Содержание

● Международная конференция Физика.СПб,
20–24 октября 2025 г., Санкт-Петербург

Лапушкин М.Н.

Адсорбция калия на поверхности $\text{Al}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{N}(0001)$. . . 251

**Казяков С.А., Дугин А.А., Гагиев Т.С., Гревцев М.А.,
Соколов А.В., Арефьева О.А., Шишкин А.Ю., Хво-
ров В.Н.**

Алгоритм селективного определения компонентов газовых смесей $\text{C}_3\text{H}_8\text{-H}_2$ и $\text{H}_2\text{-CH}_4$ при исследовании температурной зависимости электропроводности полупроводникового сенсора на основе SnO_2 255

Клычков Н.А., Симаков В.В., Синев И.В.

Использование освещения для идентификации газовых сред полупроводниковыми сенсорами на основе оксида цинка . 259

Карлина Л.Б., Власов А.С., Левин Р.В., Сошников И.П.

Самокаталитический рост GaInP-наноструктур на подложках кремния из паровой фазы: выбор состава источника и каталитических капель 265

**Шершунова Е.А., Мошкунев С.И., Хомич В.Ю.,
Иголкин А.А.**

Мощный импульсный повышающий преобразователь на нитрид-галлиевых транзисторах 270

**Богданов А.А., Люблинский А.Г., Михайлов Е.М.,
Тубольцев Ю.В.**

Установка для испытания чипов полевых транзисторов на устойчивость к лавинному пробое при работе на индуктивную нагрузку 274

**Малевская А.Д., Минтаиров М.А., Евстропов В.В.,
Малевский Д.А., Салий Р.А., Калюжный Н.А.**

Влияние резистивных параметров фотоэлектрических преобразователей на карты электролюминесценции и вольт-амперные характеристики 281

**Поздеев В.А., Вячеславова Е.А., Михайлов О.П.,
Максимова А.А., Гудовских А.С., Уваров А.В.**

Исследование влияния параметров центрифугирования и состава суспензии PEDOT:PSS на характеристики солнечных элементов $b\text{-Si/PEDOT:PSS}$ 286

**Шварц М.З., Емельянов В.М., Корниенко П.Д., Ла-
рионов В.Р., Левина С.А., Минтаиров С.А., Нахимо-
вич М.В., Салий Р.А., Калюжный Н.А.**

Метаморфные InGaAs/GaAs-гетероструктуры для радиационно стойких фотопреобразователей лазерного излучения 291

**Мясоедов А.В., Мынбаева М.Г., Приображен-
ский С.Ю., Амельчук Д.Г., Лебедев С.П., Лебедев А.А.**

Применение композитных подложек $6H\text{-SiC}/3C\text{-SiC}(001)$ для выращивания кубического политипа карбида кремния методом сублимации 294

**Маслова Н.А., Данилов Д.В., Вывенко О.Ф., Скура-
тов В.А., Володин В.А., Калядин А.Е., Соболев Н.А.**

Комплексы собственных точечных дефектов в кремнии, сформированные в результате ионной имплантации ксенона высоких энергий и постимплантационных отжигов . . 298

**Середин Б.М., Попов В.П., Малибашев А.В., Степ-
ченко А.Д., Заиченко А.Н.**

Использование углерода для формирования дискретных зон на основе алюминия при их термомиграции в кремнии 302

**Вывенко О.Ф., Гогина О.А., Петров Ю.В., Убий-
вовк Е.В., Аргунова Т.С., Нагалюк С.С.**

Дислокационная структура индентированных объемных кристаллов AlN 306

**Бекман А.А., Мельниченко И.А., Шерняков Ю.М.,
Корнышов Г.О., Гордеев Н.Ю., Паюсов А.С., Сим-
чук О.И., Ткач Ю.С., Максимов М.В.**

Спектральные и пространственные характеристики излучения торцевых лазерных диодов на основе квантовых ям InGaAs/GaAs со сверхшироким волноводом 310